

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

U.S.P.T.O.
JP821 10/1028189
10/24/01

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 4月19日

出願番号

Application Number:

特願2001-121238

出願人

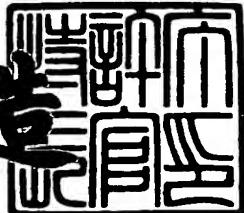
Applicant(s):

松下電器産業株式会社

2001年 7月27日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3065054

【書類名】 特許願

【整理番号】 R5478

【提出日】 平成13年 4月19日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G11B 7/24

G11B 7/00

G11B 11/10

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式
会社内

【氏名】 内田 清

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式
会社内

【氏名】 日野 泰守

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式
会社内

【氏名】 村上 元良

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式
会社内

【氏名】 宮武 範夫

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100095555

【弁理士】

【氏名又は名称】 池内 寛幸

【電話番号】 06-6361-9334

【選任した代理人】

【識別番号】 100076576

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐藤 公博

【選任した代理人】

【識別番号】 100107641

【弁理士】

【氏名又は名称】 鎌田 耕一

【選任した代理人】

【識別番号】 100110397

【弁理士】

【氏名又は名称】 扉丘 圭司

【選任した代理人】

【識別番号】 100115255

【弁理士】

【氏名又は名称】 辻丸 光一郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100115152

【弁理士】

【氏名又は名称】 黒田 茂

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000-332051

【出願日】 平成12年10月31日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012162

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0004605

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光ディスクおよびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板と前記基板の上方に配置された記録層とを備え、前記基板側から入射される光を用いてD W D D方式によって情報信号の再生を行う光ディスクであって、

前記基板と前記記録層との間に配置された第1の誘電体層と、前記記録層に対して前記基板とは反対側に配置された第2の誘電体層とを備え、

前記記録層が前記第2の誘電体層側から入射される波長 λ の光を用いて初期化された層であり、

前記第2の誘電体層の厚さが、 $\lambda / (12 \times n)$ 以上 $\lambda / (2 \times n)$ 以下（ただし、nは第2の誘電体層の屈折率）であることを特徴とする光ディスク。

【請求項2】 前記第2の誘電体層は、窒化シリコンからなり且つ厚さが40nm～60nmの範囲内であり、

前記波長 λ が400nm～410nmの範囲内である請求項1に記載の光ディスク。

【請求項3】 前記第2の誘電体層は、窒化シリコンからなり且つ厚さが25nm～30nmの範囲内であり、

前記波長 λ が400nm～440nmの範囲内である請求項1に記載の光ディスク。

【請求項4】 前記第2の誘電体層の屈折率が、前記第1の誘電体層の屈折率よりも大きい請求項1に記載の光ディスク。

【請求項5】 前記記録層の感度を調整するために前記第2の誘電体層上に配置された熱伝導調整層をさらに備える請求項1に記載の光ディスク。

【請求項6】 前記第2の誘電体層に対して前記基板とは反対側に形成された保護コート層をさらに備え、

前記保護コート層が前記基板よりも薄い請求項1ないし5のいずれかに記載の光ディスク。

【請求項7】 前記基板の前記記録層側の表面に段差が形成されており、前記

記録層の記録トラックが前記段差によって磁気的に分離されている請求項1ないし6のいずれかに記載の光ディスク。

【請求項8】 基板と前記基板の上方に配置された記録層とを備え、前記基板側から入射される光を用いてD W D D方式によって情報信号の再生を行う光ディスクの製造方法であって、

(i) 前記基板上に、第1の誘電体層と前記記録層と第2の誘電体層とをこの順序で形成する工程と、

(ii) 前記記録層に対して前記第2の誘電体層側から初期化用レーザ光を照射することによって、前記記録層の一部の磁気的な結合を減少させる初期化を行う工程とを含むことを特徴とする光ディスクの製造方法。

【請求項9】 前記初期化用レーザ光の波長が λ であり、

前記第2の誘電体層の厚さが、 $\lambda / (12 \times n)$ 以上 $\lambda / (2 \times n)$ 以下（ただし、nは第2の誘電体層の屈折率）である請求項8に記載の光ディスクの製造方法。

【請求項10】 前記初期化用レーザ光が、開口数が0.65以上の対物レンズで集光されたレーザ光である請求項8または9に記載の光ディスクの製造方法。

【請求項11】 前記(ii)の工程の際に、前記記録層にトラッキングサーボ用レーザ光を照射してトラッキングサーボを行う請求項8ないし10のいずれかに記載の光ディスクの製造方法。

【請求項12】 前記初期化用レーザ光の波長が、前記トラッキングサーボ用レーザ光の波長よりも短い請求項11に記載の光ディスクの製造方法。

【請求項13】 前記(ii)の工程のうちに、

前記第2の誘電体層上に、前記記録層の感度を調整するための熱伝導調整層を形成する工程をさらに含む請求項8ないし12のいずれかに記載の光ディスクの製造方法。

【請求項14】 基板と前記基板の上方に配置された記録層とを備え、前記基板側から入射される光を用いてD W D D方式によって情報信号の再生を行う光ディスクであって、

前記基板には、サンプルサーボ方式でトラッキング制御を行うためのサンプルサーボピットが形成されており、

前記基板の記録再生領域には、記録トラックとなる溝が同心円状またはスパイラル状に形成されており、

前記記録トラックのトラックピッチが $0.5 \mu\text{m} \sim 0.6 \mu\text{m}$ の範囲内であり

前記記録トラックは、波長 λ が $400 \text{ nm} \sim 440 \text{ nm}$ の範囲内であるレーザ光のレーザスポットを溝間部に走査することによって、隣接する記録トラックと磁気的に遮断されていることを特徴とする光ディスク。

【請求項15】 前記基板と前記記録層との間に配置された第1の誘電体層と、前記記録層に対して前記基板とは反対側に配置された第2の誘電体層とを備え

前記記録トラックは、前記第2の誘電体層側からレーザ光を照射することによって隣接する記録トラックと磁気的に遮断されている請求項14に記載の光ディスク。

【請求項16】 前記第2の誘電体層の厚さが、 $\lambda / (12 \times n)$ 以上 $\lambda / (2 \times n)$ 以下（ただし、nは第2の誘電体層の屈折率である）である請求項15に記載の光ディスク。

【請求項17】 前記溝の部分の反射率 R_G と、前記溝間部の反射率 R_L とが、 $0.95 < R_G / R_L \leq 1.0$ を満たす請求項14ないし16のいずれかに記載の光ディスク。

【請求項18】 基板と前記基板の上方に配置された記録層とを備え、前記基板側から入射される光を用いてDWDW方式によって情報信号の再生を行う光ディスクであって、

前記基板には、サンプルサーボ方式でトラッキング制御を行うためのサンプルサーボピットが形成されており、

前記基板の記録再生領域には、同心円状またはスパイラル状に記録トラックが形成されており、

前記記録トラックのトラックピッチが $0.5 \mu\text{m} \sim 0.6 \mu\text{m}$ の範囲内であり

前記記録トラックは、波長 λ が400 nm～440 nmの範囲内であるレーザ光のレーザスポットを走査することによって、隣接する記録トラックと磁気的に遮断されており、

前記記録トラックの反射率 R_R と、隣接する記録トラックの間の領域の反射率 R_M とが $0.95 < R_R / R_M \leq 1.0$ を満たすことを特徴とする光ディスク。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、情報の記録または再生に用いられる光ディスクとその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

光ディスクの分野では、より高密度に情報を記録することが求められている。このような高密度記録を実現する方法として、DWDD (Domain Wall Displacement Detection) 方式（磁壁移動検出方式）の光ディスクが提案されている。

【0003】

DWDD方式の光ディスクでは、隣接する記録トラック間で磁気的な結合を弱める必要がある。このため、DWDD方式の光ディスクを製造する場合には、情報信号の記録を行う前に、隣接する記録トラック間の磁気的な結合を弱める初期化を行う。このような初期化の方法については、従来から報告されている（特開平6-290496号公報や特開平10-340493号公報参照）。

【0004】

従来の光ディスクの構造および初期化の方法について、一例を図10に示す。図10に示すように、従来の光ディスク1は、基板2と、基板2上に順次積層された第1の誘電体層3、記録層4、第2の誘電体層5および保護コート層6とを備える。基板2の記録層4側の表面には、グループ2aが形成されている。径方向に隣接する2つのグループ2a間は、ランドと呼ばれる部分であり、この部分

が記録トラックとなる。グループ2aの幅はたとえば0.2μmであり、ランド部の幅は1.4μmである。記録層4は、DWDD方式で再生を行うために3層以上の磁性体層を備える。

【0005】

次に、光ディスク1の初期化方法について説明する。光ディスク1の初期化では、グループ2aに沿ってアニール用のレーザ光7（レーザパワー：10mW、 $\lambda = 780\text{ nm}$ 、対物レンズ8のNA=0.5、光スポットの直径：約800nm）を照射することによって、グループ2a上の記録層4の磁気的結合を消失させる。この初期化工程において、レーザ光7の光スポットの移動速度は、たとえば2m/secである。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記のような初期化方法では、グループ2a以外の部分にも光スポットが照射されてしまうため、有効な記録トラックが狭くなり、信号レベルが低下するという問題があった。そのため、記録層4に照射される光スポットを小さくすることが必要となるが、第1の誘電体層3は、記録・再生用のレーザ光の波長にあわせて最適化されているため、アニール用のレーザ光7の光スポットを小さくすることが困難であるという問題があった。また、同様の理由で、記録層4におけるアニール用のレーザ光7の吸収効率を上げることが困難であったため、速い線速度で初期化を行うことができず、初期化に時間がかかるという問題があった。

【0007】

上記問題を解決するため、本発明は、記録密度が高く、短時間で初期化することができる光ディスクおよびその製造方法を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明の第1の光ディスクは、基板と前記基板の上方に配置された記録層とを備え、前記基板側から入射される光を用いてDWDD方式によって情報信号の再生を行う光ディスクであって、前記基板と前記記録層

との間に配置された第1の誘電体層と、前記記録層に対して前記基板とは反対側に配置された第2の誘電体層とを備え、前記記録層が前記第2の誘電体層側から入射される波長 λ の光を用いて初期化された層であり、前記第2の誘電体層の厚さが、 $\lambda / (12 \times n)$ 以上 $\lambda / (2 \times n)$ 以下（ただし、nは第2の誘電体層の屈折率）であることを特徴とする。上記光ディスクでは、初期化用のレーザ光にあわせて第2の誘電体層の厚さを規定しているため、初期化用のレーザ光のスポットを小さくでき、また、初期化用のレーザ光によるアニールの効率を高めることができる。したがって、上記光ディスクによれば、記録密度が高く、短時間で初期化することができる光ディスクが得られる。なお、この明細書で「初期化」とは、記録層の一部をアニールすることによって記録トラック間の磁気的な結合を弱める工程をいう。

【0009】

上記第1の光ディスクでは、前記第2の誘電体層は、窒化シリコンからなり且つ厚さが40nm～60nmの範囲内であり、前記波長 λ が400nm～410nmの範囲内であってもよい。上記構成によれば、第2の誘電体層が薄いため、生産性よく製造することが可能になる。また、上記構成によれば、十分な耐腐食性が得られる。

【0010】

上記第1の光ディスクでは、前記第2の誘電体層は、窒化シリコンからなり且つ厚さが25nm～30nmの範囲内であり、前記波長 λ が400nm～440nmの範囲内であってもよい。上記構成によれば、第2の誘電体層が薄いため、生産性よく製造することが可能になる。また、上記構成によれば、十分な耐腐食性が得られる。さらに、上記構成によれば、光の吸収量を大きくすることができ、初期化を行うために必要なレーザ光のエネルギーを低下させることができる。

【0011】

上記第1の光ディスクでは、前記第2の誘電体層の屈折率が、前記第1の誘電体層の屈折率よりも大きくてもよい。上記構成によれば、比較的薄い第2の誘電体層でも初期化用のレーザ光を効率よく利用できるため、第2の誘電体層の成膜時間を短縮できる。

【0012】

上記第1の光ディスクでは、前記記録層の感度を調整するために前記第2の誘電体層上に配置された熱伝導調整層をさらに備えてもよい。上記構成によれば、記録層の感度を調整できるとともに、記録や再生が可能なパワー範囲を広げることができる。

【0013】

上記第1の光ディスクでは、前記第2の誘電体層に対して前記基板とは反対側に形成された保護コート層をさらに備え、前記保護コート層が前記基板よりも薄くてもよい。上記構成によれば、保護コート層を通じて記録層に、大きなNAのレンズでレーザ光を照射することができ、アニール幅を小さくすることができる。

【0014】

上記第1の光ディスクでは、前記基板の前記記録層側の表面に段差が形成されており、前記記録層の記録トラックが前記段差によって磁気的に分離されていてもよい。上記構成によれば、ランド部に初期化用レーザを照射することによって光の閉じ込め効果を利用して狭い幅をアニールすることができ、記録トラック間の磁気的な結合を遮断することが容易で且つトラックピッチを狭くすることが可能な光ディスクが得られる。また、グループを記録トラックとして用いることによって、面粗さが少ない部分を記録トラックとして使用することになり、DWD D特性が良好な光ディスクが得られる。

【0015】

また、上記目的を達成するため、本発明の光ディスクの製造方法は、基板と前記基板の上方に配置された記録層とを備え、前記基板側から入射される光を用いてDWD D方式によって情報信号の再生を行う光ディスクの製造方法であって、(i) 前記基板上に、第1の誘電体層と前記記録層と第2の誘電体層とをこの順序で形成する工程と、(ii) 前記記録層に対して前記第2の誘電体層側から初期化用レーザ光を照射することによって、前記記録層の一部の磁気的な結合を減少させる初期化を行う工程とを含むことを特徴とする。上記光ディスクの製造方法によれば、記録密度が高い光ディスクを生産性よく製造できる。

【0016】

上記製造方法では、前記初期化用レーザ光の波長が λ であり、前記第2の誘電体層の厚さが、 $\lambda/(12 \times n)$ 以上 $\lambda/(2 \times n)$ 以下（ただし、nは第2の誘電体層の屈折率）であることが好ましく、 $\lambda/(4 \times n)$ の近傍であることが特に好ましい。

【0017】

上記製造方法では、前記初期化用レーザ光が、開口数が0.65以上の対物レンズで集光されたレーザ光であってもよい。上記構成によれば、レーザスポットを小さくすることができ、記録密度が特に高い光ディスクを製造できる。

【0018】

上記製造方法では、前記(ii)の工程の際に、前記記録層にトラッキングサーボ用レーザ光を照射してトラッキングサーボを行ってもよい。上記構成によれば、トラッキング制御の精度が向上するため、アニールの半径方向の位置精度も向上し、D W D D動作が安定する。

【0019】

上記製造方法では、前記初期化用レーザ光の波長が、前記トラッキングサーボ用レーザ光の波長よりも短くてもよい。上記構成によれば、トラック密度を向上させることができる。

【0020】

上記製造方法では、前記(ii)の工程のうちに、前記第2の誘電体層上に、前記記録層の感度を調整するための熱伝導調整層を形成する工程をさらに含んでもよい。

【0021】

また、本発明の第2の光ディスクは、基板と前記基板の上方に配置された記録層とを備え、前記基板側から入射される光を用いてD W D D方式によって情報信号の再生を行う光ディスクであって、前記基板には、サンプルサーボ方式でトラッキング制御を行うためのサンプルサーボピットが形成されており、前記基板の記録再生領域には、記録トラックとなる溝が同心円状またはスパイラル状に形成されており、前記記録トラックのトラックピッチが0.5μm～0.6μmの範

囲内であり、前記記録トラックは、波長 λ が400nm～440nmの範囲内であるレーザ光のレーザスポットを溝間部に走査することによって、隣接する記録トラックと磁気的に遮断されていることを特徴とする。

【0022】

上記第2の光ディスクでは、前記基板と前記記録層との間に配置された第1の誘電体層と、前記記録層に対して前記基板とは反対側に配置された第2の誘電体層とを備え、前記記録トラックは、前記第2の誘電体層側からレーザ光を照射することによって隣接する記録トラックと磁気的に遮断されていてもよい。

【0023】

上記第2の光ディスクでは、前記第2の誘電体層の厚さが、 $\lambda / (12 \times n)$ 以上 $\lambda / (2 \times n)$ 以下（ただし、nは第2の誘電体層の屈折率である）であってもよい。上記第2の光ディスクによれば、高密度に情報を記録することが可能になる。また、上記第2の光ディスクでは、波長が600nm～650nmの範囲内のレーザ光を用いて再生を行うことができる。このような波長範囲のレーザ光の光源（レーザダイオード）は、入手しやすい、高パワーを出せる、特性が安定しているといった利点がある。

【0024】

上記第2の光ディスクでは、前記溝の部分の反射率 R_G と、前記溝間部の反射率 R_L とが、 $0.95 < R_G / R_L \leq 1.0$ を満たしてもよい。

【0025】

また、本発明の第3の光ディスクは、基板と前記基板の上方に配置された記録層とを備え、前記基板側から入射される光を用いてDWDD方式によって情報信号の再生を行う光ディスクであって、前記基板には、サンプルサーボ方式でトラッキング制御を行うためのサンプルサーボピットが形成されており、前記基板の記録再生領域には、同心円状またはスパイラル状に記録トラックが形成されており、前記記録トラックのトラックピッチが $0.5\mu m$ ～ $0.6\mu m$ の範囲内であり、前記記録トラックは、波長 λ が400nm～440nmであるレーザ光のレーザスポットを走査することによって、隣接する記録トラックと磁気的に遮断されており、前記記録トラックの反射率 R_R と、隣接する記録トラックの間の領域

の反射率 R_M とが $0.95 < R_R / R_M \leq 1.0$ を満たすことを特徴とする。上記第3の光ディスクによれば、高密度に情報を記録することが可能になる。また、上記第3の光ディスクでは、波長が $600\text{ nm} \sim 650\text{ nm}$ の範囲内のレーザ光を用いて再生を行うことができる。このような波長範囲のレーザ光の光源（レーザダイオード）は、入手しやすい、高パワーを出せる、特性が安定しているといった利点がある。

【0026】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。

【0027】

(実施形態1)

実施形態1では、本発明の光ディスクについて一例を説明する。実施形態1の光ディスク10について、一部断面図を図1に示す。

【0028】

図1を参照して、光ディスク10は、基板11と、基板11の上方に配置された記録層12と、基板11と記録層12との間に配置された第1の誘電体層13と、記録層12に対して基板11とは反対側に配置された第2の誘電体層14と、第2の誘電体層14上に配置された保護コート層15とを備える。光ディスク10は、基板11側から入射される光を用いて情報信号の再生を行う光ディスクである。

【0029】

基板11は、円板状の基板である。基板11には、たとえば、ポリカーボネートやガラス等からなる基板を用いることができ、厚さは、たとえば $0.5\text{ mm} \sim 1.2\text{ mm}$ 程度である。なお、図4および5に示すように、基板11の記録層12側の表面に段差が形成されており、記録層12が段差によって磁気的に分離されていてもよい。

【0030】

第1の誘電体層13および第2の誘電体層14には、たとえば、 Si_3N_4 などの窒化シリコン、 AlN 、 SiO_2 、 SiO 、 ZnS 、 MgF_2 などの透明誘電材

料が使用できる。

【0031】

第2の誘電体層14の厚さは、第2の誘電体層14側から初期化用のレーザ光を照射したときに、その反射率が低く、光が効率よく吸収されるように設定される。具体的には、第2の誘電体層14の厚さは、 $\lambda / (4 \times n)$ の前後が好ましく、 $\lambda / (12 \times n)$ 以上 $\lambda / (2 \times n)$ 以下（好ましくは、 $\lambda / (6 \times n)$ 以上 $\lambda / (2 \times n)$ 以下）である。従来の光ディスクとは異なり、光ディスク10では、第2の誘電体層14側から初期化用（アニール用）のレーザ光を照射して初期化を行うことによって、効率的に初期化を行うことができる。また、光ディスク10では、初期化用のレーザ光の光スポットを小さくできるため、記録トラックの実質的な幅を広くすることができる。また、記録層12における初期化用のレーザ光の吸収効率を高めることができるために、光スポットを速い線速度で走査することができ、初期化時間を短縮できる。

【0032】

具体的には、第2の誘電体層14として、屈折率が約2である窒化シリコンを用い、初期化用のレーザ光の波長 λ が400nm～410nmの範囲内である場合には、第2の誘電体層14の厚さを40nm～60nmの範囲内とすることができます。また、第2の誘電体層14として、屈折率が約2である窒化シリコンを用い、初期化用のレーザ光の波長 λ が400nm～440nmの範囲内である場合には、第2の誘電体層14の厚さを25nm～30nmの範囲内とすることができます。

【0033】

保護コート層15は、基板11と同様の材料を用いて形成できるが、基板11よりも屈折率が大きいことが好ましい。保護コート層15は、たとえば、紫外線硬化性樹脂を塗布して硬化させて形成してもよいし、第2の誘電体層14上に基板を貼り合わせてもよい。

【0034】

記録層12は、DWDW方式で再生が可能なように3層以上の磁性体層を含む。記録層12は、第2の誘電体層14側から入射された波長 λ の光を用いて初期

化された層である。記録層12の一例として、記録層12が、基板11側から順に積層された第1の磁性体層21、第2の磁性体層22および第3の磁性体層23を含む場合には、各層の材料として、以下のものを用いることができる。第1の磁性体層21の材料には、小さな磁壁抗磁力を有し、第2の磁性体層22のキュリー温度近傍の温度範囲で飽和磁化が小さな材料で、そのキュリー温度が第3の磁性体層23よりも低く第2の磁性体層22よりも高い材料を用いることができる。たとえば、GdCoやGdFeCo、またはその合金でキュリー温度が20°C~260°C程度のものを用いることができる。

【0035】

第2の磁性体層22の材料としては、キュリー温度が第1の磁性体層21や第3の磁性体層23よりも低いものであり、そのキュリー温度直下まで大きな磁壁抗磁力を有する材料を用いることが好ましい。たとえば、DyFeやTbFe、またはその合金を用いることができ、その典型的なキュリー温度として140°C~180°Cのものを用いることができる。

【0036】

第3の磁性体層23は大きな磁壁抗磁力を有し、第1の磁性体層21や第2の磁性体層22よりも高いキュリー温度を有し、第2の磁性体層22のキュリー温度近傍の温度範囲で飽和磁化が小さな材料を用いることができる。たとえば、TbFeCo、またはその合金で、キュリー温度が280°C~300°Cのものを用いることができる。

【0037】

以下では、記録層12が、基板11側から順に積層された第1の磁性体層21、第2の磁性体層22および第3の磁性体層23を含む光ディスクについて、図2を用いてその機能を説明する。

【0038】

図2(a)に、再生用レーザ光が照射されていないときの記録層12の状態を模式的に示す。情報信号は、第3の磁性体層23に磁化情報として記録される。再生用レーザ光が照射されていない状態では、第1の磁性体層21、第2の磁性体層22および第3の磁性体層23が交換結合しているため、第3の磁性体層2

3の磁化情報が第2の磁性体層22および第1の磁性体層21に転写されている。

【0039】

再生用レーザ光を照射したときの記録層12の状態を、図2(b)に模式的に示す。再生用レーザ光は、光ディスクに対して矢印の方向に相対的に移動する。再生用レーザ光が照射されて各層の温度が上昇すると、第2の磁性体層22の一部に、温度がキュリー温度以上となる部分22p(図中の斜線で表す)が生じる。部分22pでは、第1の磁性体層21と第3の磁性体層23との交換結合が遮断される。このとき、温度に依存する磁壁エネルギー密度の勾配によって、第1の磁性体層21の磁壁が移動する。このため、部分22pに隣接するする第1の磁性体層21には、拡大された磁区21aが存在する。そして、部分22pの前方(基板11に対する再生用レーザ光の相対的な移動方向を前方とする。図2(b)の矢印の方向である。)に位置する磁区22aを介して、第3の磁性体層23の磁区23aの情報が拡大された磁区21aに転写されている。

【0040】

図2(b)の状態から再生用レーザ光が前方に移動すると、図2(c)に示すように、磁区22aの温度が上昇して部分22pとなる。このとき、部分22pの前方に位置する磁区22bに隣接する磁区21bの磁壁が移動する。そして、図2(d)に示すように、拡大された磁区21bが形成される。そして、拡大された磁区21bには、第2の磁性体層22を介して磁区23bの情報が転写されている。

【0041】

このように、DWDD方式では、第3の磁性体層23に記録された情報が拡大されて第1の磁性体層21に転写される。したがって、DWDD方式では、再生用レーザ光のスポット径よりも小さい磁区の情報を再生することが可能となる。光ディスク10では、DWDD方式によって再生を行うことによって、特に高密度に情報を記録・再生することが可能である。なお、このような微少な磁区への記録は、光パルス磁界変調記録などによって行うことができる。

【0042】

以上のように、実施形態1の光ディスク10によれば、記録密度が高く、短時間で初期化することができる光ディスクが得られる。

【0043】

なお、本発明の光ディスクは、第2の誘電体層14と保護コート層15との間に、記録層12の感度を調節するための熱伝導調整層をさらに備えてもよい。熱伝導調整層には、金属膜を用いることができ、たとえば、アルミニウムや金からなる膜を用いることができる。熱伝導調整層の厚さは、一般的には、50nm～500nm程度である。

【0044】

(実施形態2)

実施形態2では、本発明の光ディスクの製造方法について一例を説明する。実施形態2の製造方法は、基板側から入射される光を用いてDWDW方式によって情報信号の再生を行う光ディスクの製造方法である。なお、以下では、実施形態1で説明した光ディスク10を製造する場合について説明する。また、上記実施形態で説明した部分と同様の部分については、同一の符号を付して重複する説明を省略する（以下の実施形態において同様である）。

【0045】

実施形態2の製造方法では、まず、基板11上に、第1の誘電体層13と記録層12と第2の誘電体層14とを、この順序で形成する（以下、この工程を工程(i)という場合がある）。これらの各層は、たとえばマグнетロンスパッタ装置によるスパッタリング法、蒸着法などによって連続的に形成できる。特に、記録層12を構成する複数の磁性体層は、真空を破ることなく連続成膜することによって磁気的な交換結合を維持させることができる。基板11から第2の誘電体層14までの間に、上記層以外の層を形成してもよい。

【0046】

上記工程(i)ののち、記録層12に対して、第2の誘電体層14側から波長λの初期化用レーザを照射することによって、記録層12の一部の磁気的な結合を弱める初期化を行う（以下、この工程を工程(ii)という場合がある）。この初期化工程については、後述する。

【0047】

なお、上記工程(i)と工程(ii)との間に、第2の誘電体層14上に保護コート層15を形成する工程を含んでもよい。また、保護コート層15は、工程(ii)ののちに行ってもよい。

【0048】

また、上記工程(ii)ののちに、第2の誘電体層14上に、実施形態1で説明した熱伝導調整層を形成する工程をさらに含んでもよい。熱伝導調整層は、スパッタリング法や蒸着法によって形成できる。この場合には、熱伝導調整層を形成したのちに、保護コート層15を形成する。

【0049】

以下に、光ディスク10の初期化工程(工程(ii))について、一例を説明する。なお、以下では、屈折率が1.58であるポリカーボネートからなる基板11と、 Si_3N_4 からなる第1の誘電体層13(厚さ70nm)と、 Si_3N_4 からなる第2の誘電体層14(厚さ130nm)と、屈折率が1.6のアクリレート系の紫外線硬化性樹脂からなる保護コート層15(厚さ20μm)とを用いた光ディスク10の初期化について説明する。同様に、以下では、記録層12が、図2に示すように、基板11側から順に積層された第1の磁性体層21、第2の磁性体層22、および第3の磁性体層23とを含む光ディスク10の初期化について説明する。ここで、第1の磁性体層21はGdCo層(厚さ30nm)であり、第2の磁性体層22はDyFe層(厚さ10nm)であり、第3の磁性体層23はTbFeCo層(厚さ40nm)である。

【0050】

光ディスク10の初期化に用いる初期化装置の一例として、初期化装置30の構成を図3に模式的に示す。図3を参照して、初期化装置30は、アニール用のレーザ光源31と、ビームスプリッタ32と、フォーカス検出器33と、対物レンズ34($\text{NA}=0.85$)と、フォーカスアクチュエータ35とを備える。なお、図3では、第1の誘電体層13と記録層12と第2の誘電体層14とをまとめて、記録再生層36としている。なお、図3では理解を容易にするために保護コート層15の図示を省略しているが、記録再生層36上には、保護コート層1

5が形成されている。

【0051】

図3の光ディスク10は、クロックピット37と、ウォブルピット38とを備える。記録再生層36の一部は、記録トラック39となる。記録・再生に用いるレーザ光の波長は、600nm～680nmの範囲内である。記録・再生用のレーザ光のレーザスポットの直径は、約0.65μm～0.75μmの範囲内である。記録トラックのトラックピッチは、0.6μm～0.7μmの範囲内である。記録・再生に用いるレーザ光に対する記録トラック39の反射率R_Rとミラー部（すなわち、隣接する2つの記録トラックの間の領域）の反射率R_Mとは、 $0.95 < R_R / R_M \leq 1.0$ を満たす。

【0052】

レーザ光源31から射出されたアニール用のレーザ光L1（波長650nm）は、ビームスプリッタ32を通過して、対物レンズ34で絞られてレーザスポットS1を形成する。初期化装置30では、保護コート層15の厚さに対応したNA0.85の対物レンズ34を使用しているため、レーザスポットS1は従来のものより小さくなり、その直径は380nmとなる。レーザスポットS1から反射した光は、対物レンズ34とビームスプリッタ32とを介してフォーカス検出器33で検出される。この検出信号に基づいてフォーカスアクチュエータ35が駆動され、レーザスポットS1の直径が大きく変化しないように制御される。

【0053】

光ディスク10の初期化は、径方向に隣接する2つの記録トラック39の間を、レーザ光L1を照射してアニールすることによって行われる。すなわち、レーザスポットS1が、隣接する2つの記録トラックの中央を走査するように、レーザ光L1を制御する。換言すれば、レーザスポットS1は、記録トラックの中心から径方向にトラックピッチの2分の1だけ離れた線上を走査する。このとき、レーザスポットS1は、光ディスク10の回転駆動機構（図示せず）と、レーザスポットS1を光ディスクの半径方向に移動させる機構（図示せず）とを用いて、光ディスク10の記録再生層36に対して適切な線速度で移動させる。このようにして、レーザ光L1を照射することによって、アニール領域100を形成す

る初期化が行われる。アニール領域100では、第1の磁性体層21と第2の磁性体層22と第3の磁性体層23とが昇温されてその磁化の様子が周辺とは異なり、磁気結合が遮断された状態となる。レーザ光源31の出射レーザパワーが50mWの場合、20m/secの線速度で、アニール領域100の幅を0.18μmにすることができた。これは、初期化に使用したレーザ光L1の波長が従来例で説明したアニール用レーザ光の波長よりも短いこと、使用した対物レンズ34のNAが従来例で説明したものよりも大きいこと、および、第2の誘電体層14の厚さをレーザ光L1の吸収が最も大きくなるように設定したことによる。

【0054】

なお、図3では、サンプルサポートトラッキング方式の光ディスクの一例を示したが、本発明の光ディスクはこれに限定されない（他の実施形態においても同様である）。たとえば、図4に示すように、ランド41とグループ42の両方が記録トラックとなる光ディスクでもよい。この場合には、ランド41とグループ42との段差部にアニール領域110を形成すればよい。また、図5に示すように、幅が狭いランド51と幅が広いグループ52とを備え、グループ52が記録トラックとなる光ディスクでもよい。この場合には、ランド51にアニール領域120を形成すればよい。また、図5とは逆に、幅が広いランドと幅が狭いグループとを備え、ランドが記録トラックとなる光ディスクでもよい。

【0055】

また、実施形態2では、第2の誘電体層14の材料として、屈折率が2.0のSi₃N₄を用いる例を示したが、第2の誘電体層14の材料として、屈折率が2.6のZnSeや屈折率が2.2のZnSを用いてもよい（他の実施形態においても同様である）。この場合には、比較的薄い第2の誘電体層14でも初期化用のレーザ光を効率よく利用できるため、第2の誘電体層14の成膜時間を短縮できるという利点がある。また、初期化用レーザ光の波長における第2の誘電体層14の複素屈折率の虚数部を0.1より小さくすることによって、初期化する時のエネルギーロスを小さくすることができ、より小さいパワーまたはより少ない時間で初期化を行うことができる。また、第2の誘電体層14における初期化用レーザ光の透過率を90%以上とすることによって、より小さいパワーまたはよ

り少ない時間で初期化を行うことができる。

【0056】

また、実施形態2では、保護コート層15が屈折率1.6のアクリレート系樹脂からなり、基板11が屈折率1.58であるポリカーボネートからなる場合について説明したが、保護コート層15の屈折率は、基板11と同程度またはそれ以下であっても本発明の効果が得られる（他の実施形態においても同様である）。

【0057】

また、実施形態2では、保護コート層15を形成した後に、レーザ光L1による初期化を実施した例を中心に説明したが、保護コート層15を形成する前に初期化を実施することも可能である（他の実施形態においても同様である）。この場合には対物レンズ34により大きなNAを有するものを採用することが可能であり、たとえばNA0.9程度のレンズを用いることができる。その結果、レーザスポットS1をより小さくすることができ、記録密度をさらに向上させることができる。

【0058】

（実施形態3）

実施形態3では、本発明の光ディスクの製造方法について他の一例を説明する。実施形態3の製造方法は、実施形態2の製造方法と、初期化の工程（工程(ii)）のみが異なるため、重複する説明は省略する。

【0059】

以下に、実施形態3における初期化の方法について説明する。実施形態3の製造方法で用いる初期化装置60の構成を、図6に模式的に示す。

【0060】

図6を参照して、初期化装置60は、アニール用のレーザ光源31と、ビームスプリッタ32、62および65と、フォーカス検出器33と、対物レンズ34と、フォーカスアクチュエータ35と、トラッキングサーボ用のレーザ光源61と、光検出器63と、トラッキングアクチュエータ64とを備える。なお、図6では、図3と同様に、保護コート層15の図示を省略している。

【0061】

次に、図6を用いて、その動作を説明する。レーザ光源61から射出されたレーザ光L2は、ビームスプリッタ62とビームスプリッタ32とを通過し、対物レンズ34で集光されてレーザスポットS2を形成する。同時に、初期化用のレーザ光源31から射出されたレーザ光L1は、ビームスプリッタ62とビームスプリッタ32とを通過して、対物レンズ34で集光されてレーザスポットS1を形成する。レーザスポットS1の中心とレーザスポットS2の中心との距離は、ほぼ記録トラック39のピッチの半分となるように設定される。また、レーザスポットS1およびS2の中心を結ぶ線が、記録トラック39の長手方向に垂直な方向になるように設定される。

【0062】

レーザスポットS2から反射した光は、対物レンズ34を経てビームスプリッタ32に入り、ビームスプリッタ65の方向にその光路を曲げて光検出器63に入る。光検出器63からの信号に適切なウインドウゲートを設けてサンプリングサーボ信号を得て、トラッキングアクチュエータ64に送って、レーザスポットS2が記録トラック39上を走査するように調整する。

【0063】

レーザスポットS1からの反射光は対物レンズ34を経てビームスプリッタ32に入り、ビームスプリッタ65の方向にその光路を曲げてフォーカス検出器33に入る。フォーカス検出器33からの信号をフォーカスアクチュエータ35に送って、フォーカスアクチュエータ35を動作させてレーザスポットS1の径が大きく変化しないように制御する。

【0064】

光ディスクの回転駆動機構（図示せず）と、レーザスポットS1およびS2を光ディスクの半径方向に移動する機構（図示せず）とを用いて、レーザスポットS1と光ディスクとを適切な線速度と送りで移動させると、隣接する記録トラック39の間にアニール領域130を作り出すことができる。アニール領域130では第1の磁性体層21と第2の磁性体層22と第3の磁性体層23とが昇温され、その磁化の様子が周辺とは異なるものとなり、磁気結合が遮断された状態と

なる。

【0065】

実施形態3の製造方法の場合、レーザスポットS2によってトラッキングサーボが可能となるため、簡単な機構で光ディスクを半径方向に移動することができる。

【0066】

また、光ディスクのアドレスなどを読み込んでアニール処理ができるため、実施形態4に示すような加熱や温度測定が可能となる。

【0067】

なお、実施形態3ではサンプルサーボトラッキング方式の光ディスクの製造方法について説明したが、実施形態2で説明した図4または図5に示す光ディスクも同様に製造できる。

【0068】

なお、実施形態3の製造方法では、レーザスポットS1の走査直前の記録再生層36を加熱してもよい（他の実施形態においても同様である）。そのような加熱は、たとえば、赤外線の照射による加熱、電磁誘導加熱、マイクロ波加熱、またはレーザ加熱などによって行うことができる。赤外線の照射によって加熱を行う場合について、初期化装置の一部を図7に模式的に示す。

【0069】

図7において、光ディスクの記録再生層36は、対物レンズ34に対して矢印の方向に相対的に移動する。図7の初期化装置は、図6の初期化装置に加えて、さらに赤外線照射装置71を備える。赤外線照射装置71は、レーザ光L1の走査直前の位置に配置されている。

【0070】

図7の初期化装置を用いた製造方法では、レーザスポットS1の走査直前の箇所に赤外線照射装置71から赤外線を照射することによって記録再生層36の温度を事前に高め、その後、レーザスポットS1を用いたアニール処理によって初期化を実施する。この赤外線照射によって記録再生層36の温度を約100℃に高めることができ、初期化に要する時間を約2割短縮することが可能であ

った。また、100℃に維持された恒温庫に光ディスクを保存後、光ディスクの温度が保たれた状態で、上述した赤外線照射とレーザスポットS1の走査とを行うことによって、初期化に要する時間をさらに1割程度短縮することができた。

【0071】

(実施形態4)

実施形態4では、本発明の光ディスクの製造方法についてその他の一例を説明する。なお、実施形態4の製造方法は、実施形態2で説明した製造方法と比べて初期化工程（工程（ii））のみが異なるため、重複する説明を省略する。

【0072】

図8に、実施形態4で用いる初期化装置80の構成の一部を模式的に示す。初期化装置80は、図6に示した初期化装置60の構成に加えて、第1の再生用のレーザ光源81、記録用の第1の磁気ヘッド82、対物レンズ83、ビームスプリッタ84、光検出器85、第2の再生用のレーザ光源91、記録用の第2の磁気ヘッド92、対物レンズ93、ビームスプリッタ94、光検出器95、作動増幅器96、および赤外線センサ97を備える。

【0073】

次に、初期化装置80の動作について図8を用いて説明する。光ディスクは、レーザスポットS1に対して、矢印の方向に相対的に移動する。図8には図示していないが図3に示したようなフォーカス制御系によってレーザスポットS1はフォーカス制御されており、図6に示したようなトラッキング制御系によってトラッキング制御が行われている。

【0074】

レーザスポットS1の走査直前の箇所の温度を測定するために、赤外線センサ97をレーザスポットS1の走査直前の箇所に設置する。この赤外線センサ97から出力される温度に関する信号を、信号ケーブル98によってレーザ光源31にフィードバックしてレーザ光源31の出力を制御する。この方式を採用することによって、たとえばアニール領域の幅の均一性を向上させ、情報の記録再生時における再生信号のレベルの安定度を向上させ、再生時のノイズレベルを低減することが可能になる。

【0075】

あるいは、レーザ光源81から出射されたレーザ光を、ビームスプリッタ84と対物レンズ83とを介して、基板11側から記録再生層36に照射してトラック制御とフォーカス制御を行い、第1の磁気ヘッド82を用いて單一周波数の矩形波型磁界を印可して記録し、その際の再生信号レベルを光検出器85にて検出してもよい。記録再生層36はその温度に応じて光磁気信号が変化するため、この特性を利用してレーザ光の照射点の温度に相当する信号を得て、信号ケーブル99によってレーザ光源31にフィードバックすることができる。この場合には、レーザスポットS1の走査直前の微細箇所に関する温度に相当する信号が得られ、アニール領域の幅の均一性をさらに向上させ、再生信号のレベルの高周波領域での安定度を向上させ、高周波領域の再生時ノイズレベルを低減することが可能である。

【0076】

また、図7に示した赤外線照射装置71のような加熱装置が存在する場合には、レーザ光源91から出射されたレーザ光を、ビームスプリッタ94と対物レンズ93とを介して、基板11側から記録再生層36の加熱装置の影響が少ない箇所に照射してトラック制御とフォーカス制御を行い、第2の磁気ヘッド92によって單一周波数の矩形波型信号を記録して、その際の信号レベルを光検出器95で検出することによって、レーザ光照射部分の記録再生層36の温度に相当する信号を得る。そして、光検出器95からの信号と光検出器85からの信号との差分を作動增幅器96を用いて増幅し、得られた信号をレーザ光源31にフィードバックしてもよい。この方法を採用すると、加熱装置がある場合でも安定した幅のアニール領域を得ることができ、大きな再生S/Nが得られる。

【0077】

なお、実施形態4では、温度測定の方法として赤外線センサ97や光磁気信号から温度相当信号を得る方法を採用したが、他の方法で温度を測定してもよい。

【0078】

(実施形態5)

実施形態5では、本発明の光ディスクおよびその製造方法について他の一例を

説明する。実施形態5の光ディスクは、実施形態1の光ディスクと比べて記録トラックの形態のみが異なるため、重複する説明は省略する。また、実施形態5の製造方法は、実施形態2の製造方法と比べて、初期化の工程（工程（ii））のみが異なるため、重複する説明は省略する。実施の形態5の光ディスク10aについて、要部を拡大した一部分解斜視図を図9に示す。なお、図9においては一部のハッチングを省略する。

【0079】

図9を参照して、光ディスク10aは、円盤状の基板11と、基板11の上方に配置された記録層12と、基板11と記録層12との間に配置された第1の誘電体層13と、記録層12に対して基板11とは反対側に配置された第2の誘電体層14と、第2の誘電体層14上に配置された保護コート層（図示せず）とを備える。

【0080】

光ディスク10aでは、ディスクの周方向に、データ領域107とピット領域108とが交互に配置されている。データ領域107には、径方向に、グループ（溝）102とランド103とが交互に配置されている。グループ102は、基板11の記録再生領域に、同心円状またはスパイラル状に配置されている。ランド103は、隣接する2つの溝（グループ102）の間の部分（溝間部）である。グループ102は、記録トラックとなる部分である。記録トラックは、記録・再生に用いるレーザ光よりも波長が短い（たとえば、 $0.5\text{ }\mu\text{m} \sim 0.6\text{ }\mu\text{m}$ の範囲内）レーザ光のレーザスポットをランド（溝間部）103に照射することによって隣接する記録トラックと磁気的に遮断されている。ここで、グループ102の反射率 R_G と、ランド103の反射率 R_L とは、 $0.95 < R_G / R_L \leq 1.0$ の関係を満たす。

【0081】

ピット領域108には、アドレスピット106と、ウォブルピット381および382とが形成されている。ウォブルピット381および382は、サンプルサーボ方式でトラッキング制御を行うためのサンプルサーボピットである。記録・再生に用いるレーザ光は、波長が $600\text{ nm} \sim 650\text{ nm}$ の範囲内であり、レ

ーザスポットの直径が約 $0.65\text{ }\mu\text{m}$ ～ $0.75\text{ }\mu\text{m}$ の範囲内である。記録トラックのトラックピッチは、 $0.5\text{ }\mu\text{m}$ ～ $0.6\text{ }\mu\text{m}$ の範囲内であり、記録再生に用いるレーザ光のレーザスポットの直径よりも小さい。ランド103の幅は、トラックピッチの25%～45%の範囲内である（ここで、トラックピッチは、グループ102の幅とランド103の幅との合計に等しい）。光ディスク10aのその他の特徴に関しては、実施形態1に記載の光ディスク10と同様である。たとえば、第2の誘電体層14の厚さが、 $\lambda/(12 \times n)$ 以上で $\lambda/(2 \times n)$ 以下（ただし、nは第2の誘電体層14の屈折率であり、 λ は初期化用レーザ光の波長である）である。

【0082】

実施形態5の光ディスクの製造方法について一例を説明する。

【0083】

まず、実施形態2と同様に、基板11上に、第1の誘電体層13と記録層12と第2の誘電体層14とを、この順序で形成する（工程（i））。

【0084】

上記工程（i）ののち、記録層12に対して第2の誘電体層14側から波長 λ の初期化用レーザを照射することによって、記録層12の一部の磁気的な結合を弱める初期化を行う。初期化装置30は、実施形態2で説明したものと同様のものを用いることができる。ただし、実施形態5の製造方法では、波長 λ が400nm～440nmの範囲内である青紫色レーザを射出するレーザ光源31を用いる。また、ビームスプリッタ32、フォーカス検出器33、対物レンズ34（NA=0.85）と、フォーカスクチュエータ35は、青紫色レーザ用に調整されたものを使用する。

【0085】

以下、図3を参照しながら初期化の工程について説明する。なお、以下の説明では、初期化用（アニール用）のレーザ光の波長が400nmである場合を例にして説明する。レーザ光源31から射出されたアニール用のレーザ光L1（波長が400nm）は、ビームスプリッタ32を通過して、対物レンズ34で絞られてレーザスポットS1を形成する。初期化装置30では、保護コート層15の厚

さに対応したNA0.85の対物レンズ34を使用しているため、レーザスポットS1は従来のものより小さくなり、その直径は約240nm程度となる。レーザスポットS1から反射した光は、対物レンズ34とビームスプリッタ32とを介してフォーカス検出器33で検出される。この検出信号に基づいてフォーカスアクチュエータ35が駆動され、レーザスポットS1の直径が大きく変化しないように制御される。

【0086】

光ディスク10の初期化は、ランド103上にレーザ光L1を照射してアニールすることによって行われる。すなわち、レーザスポットS1が、ランド103の中央を走査するように、たとえばプッシュプルトラッキング制御方法などを利用してレーザ光L1の位置を制御する。このとき、光ディスク10の回転駆動機構（図示せず）と、レーザスポットS1を光ディスクの径方向に移動させる機構（図示せず）とを用いて、光ディスク10の記録再生層36に対して適切な線速度でレーザスポットS1を移動させる。レーザ光L1が照射されたランド103では、第1の磁性体層21と第2の磁性体層22と第3の磁性体層23とが昇温されて、その磁化の様子が周辺とは異なり、磁気結合が遮断された状態となる。このようにして、レーザ光L1をランド103上に照射することによってランド103の初期化が行われる。レーザ光源31の出射レーザパワーが6mWの場合、3m/secの線速度で、ランド103内のアニール領域（初期化領域）の幅を約0.2μm以下にすることができた。これは、青紫色レーザを初期化に使用したこと、使用した対物レンズ34のNAが従来例で説明したものよりも大きいこと、レーザ光L1の反射を小さくしてレーザ光L1の吸収量が大きくなるように第2の誘電体層14の厚さを設定したこと、および、凸部形状のランド103部に光スポットを照射することにより光が凸部に吸収され実質的に狭いアニール幅が実現できたことによるものである。

【0087】

（実施形態6）

実施形態6では、本発明の光ディスクのその他の一例について説明する。なお、上記実施形態で説明した部分と同様の部分については重複する説明を省略する

【0088】

実施形態6の光ディスクは、基板と基板の上方に配置された記録層とを備え、基板側から入射される光を用いてD W D D方式によって情報信号の再生を行う光ディスクである。

【0089】

具体的には、実施形態1の光ディスクと同様に、基板11と、基板11の上方に配置された記録層12と、基板11と記録層12との間に配置された第1の誘電体層13と、記録層12に対して基板11とは反対側に配置された第2の誘電体層14と、第2の誘電体層14上に配置された保護コート層15とを備える。

【0090】

実施形態6の光ディスクでは、第2の誘電体層の厚さに限定はないが、実施形態1と同様の厚さに設定することが好ましい。

【0091】

そして、実施形態6の光ディスクは、基板に、サンプルサーボ方式でトラッキング制御を行うためのサンプルサーボピットが形成されており、基板の記録再生領域には、同心円状またはスパイラル状に記録トラックが形成されている。そして、実施形態6の光ディスクでは、記録・再生に用いるレーザ光は、波長が600 nm～650 nmの範囲内であり、レーザスポットの直径が約0.65 μm～0.75 μmの範囲内である。また、記録トラックのトラックピッチは、0.5 μm～0.6 μmの範囲内であり、記録再生に用いるレーザ光のレーザスポットの直径よりも小さい。また、記録トラックは、記録・再生に用いるレーザ光よりも波長が短いレーザスポットを走査することによって、隣接する記録トラックと磁気的に遮断されている。そして、記録・再生に用いるレーザ光に対する記録トラックの反射率 R_R とミラー部（すなわち、隣接する2つの記録トラックの間の領域）の反射率 R_M とは、 $0.95 < R_R / R_M \leq 1.0$ を満たす。

【0092】

以上、本発明の実施形態について例を挙げて説明したが、本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の技術的思想に基づき他の実施形態に適用することがで

きる。

【0093】

【発明の効果】

以上のように、本発明の光ディスクおよびその製造方法では、記録トラック間のアニール領域の幅を小さくでき、しかもアニール領域の幅の均一性を高くできる。このため、本発明の光ディスクによれば、記録密度が高く、信号レベルが大きく、ノイズが低い光ディスクが得られる。しかも、アニールする際の走査の速度を早めることができるために、短時間で初期化が可能であり、生産性が格段に向上するという顕著な効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の光ディスクについて一例を示す一部断面図である。

【図2】 本発明の光ディスクの機能を示す模式図である。

【図3】 本発明の光ディスクの製造方法について一工程の一例を模式的に示す斜視図である。

【図4】 本発明の光ディスクの製造方法によって製造される光ディスクについて一例の構造を模式的に示す斜視図である。

【図5】 本発明の光ディスクの製造方法によって製造される光ディスクについて他の一例の構造を模式的に示す斜視図である。

【図6】 本発明の光ディスクの製造方法について一工程の他の一例を模式的に示す斜視図である。

【図7】 本発明の光ディスクの製造方法について一工程のその他の一例を模式的に示す断面図である。

【図8】 本発明の光ディスクの製造方法について一工程のその他の一例を模式的に示す斜視図である。

【図9】 本発明の光ディスクについて他の一例を示す一部分解斜視図である。

【図10】 従来の光ディスクの製造方法について一例を示す断面図である。

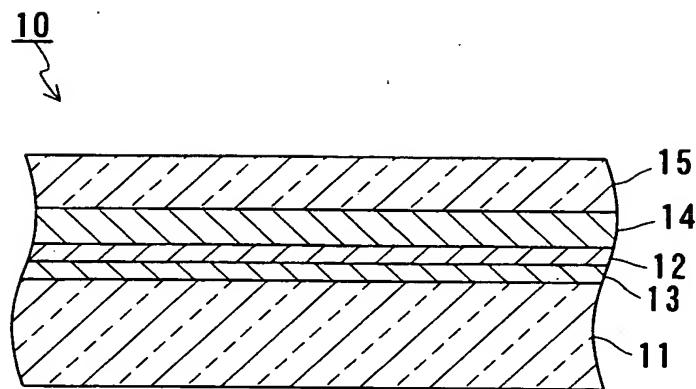
【符号の説明】

10、10a 光ディスク

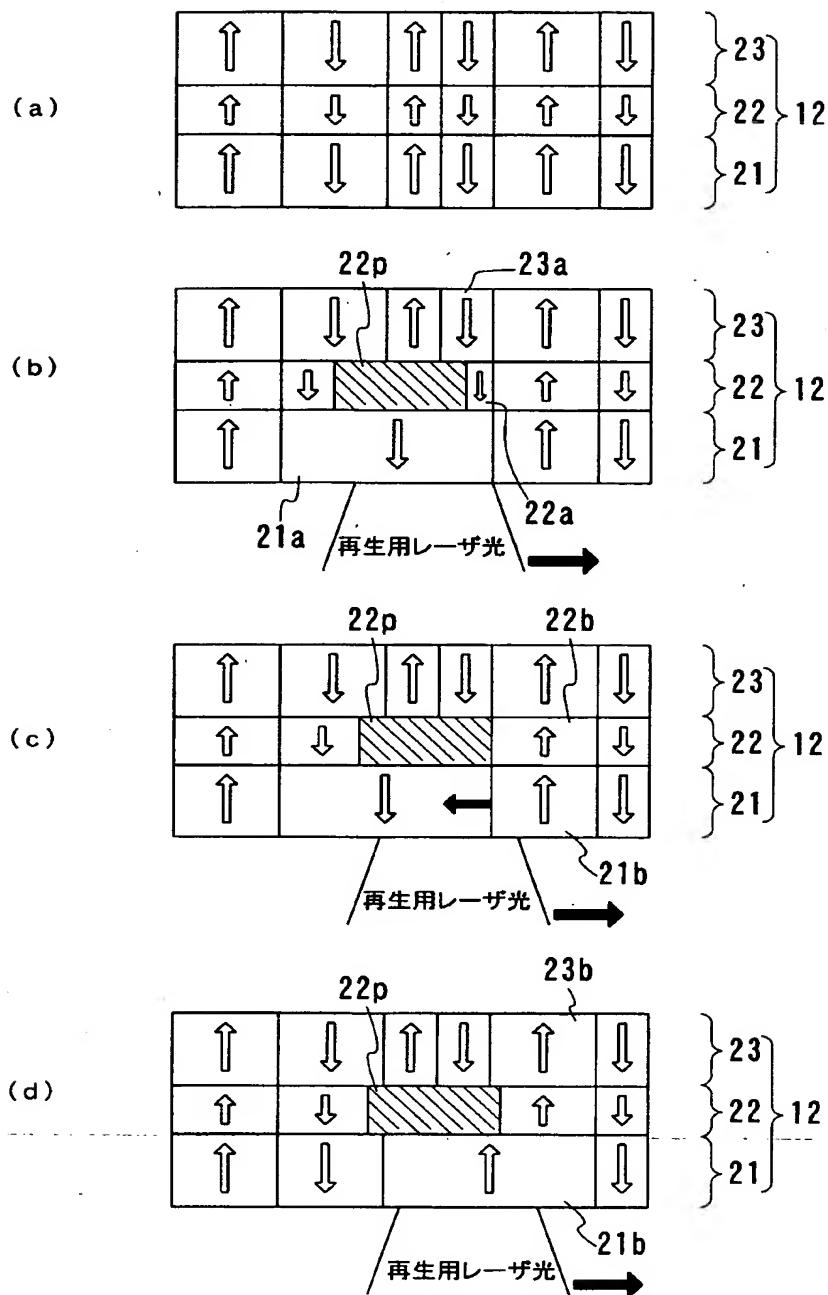
- 1 1 基板
- 1 2 記録層
- 1 3 第1の誘電体層
- 1 4 第2の誘電体層
- 1 5 保護コート層
- 2 1 第1の磁性体層
- 2 2 第2の磁性体層
- 2 3 第3の磁性体層
- 3 0、60、80 初期化装置
- 3 1、61、81、91 レーザ光源
- 3 4、83、93 対物レンズ
- 3 6 記録再生層
- 3 9 記録トラック
- 4 1、51 ランド
- 4 2、52 グループ
- 7 1 赤外線照射装置
- 1 0 0、110、120、130 アニール領域
- 1 0 2 グループ（溝）
- 1 0 3 ランド（溝間部）
- 1 0 6 アドレスピット
- 1 0 7 データ領域
- 1 0 8 ピット領域
- 3 8 1、3 8 2 ウオブルピット（サンプルサーボピット）
- L 1、L 2 レーザ光
- S 1、S 2 レーザスポット

【書類名】 図面

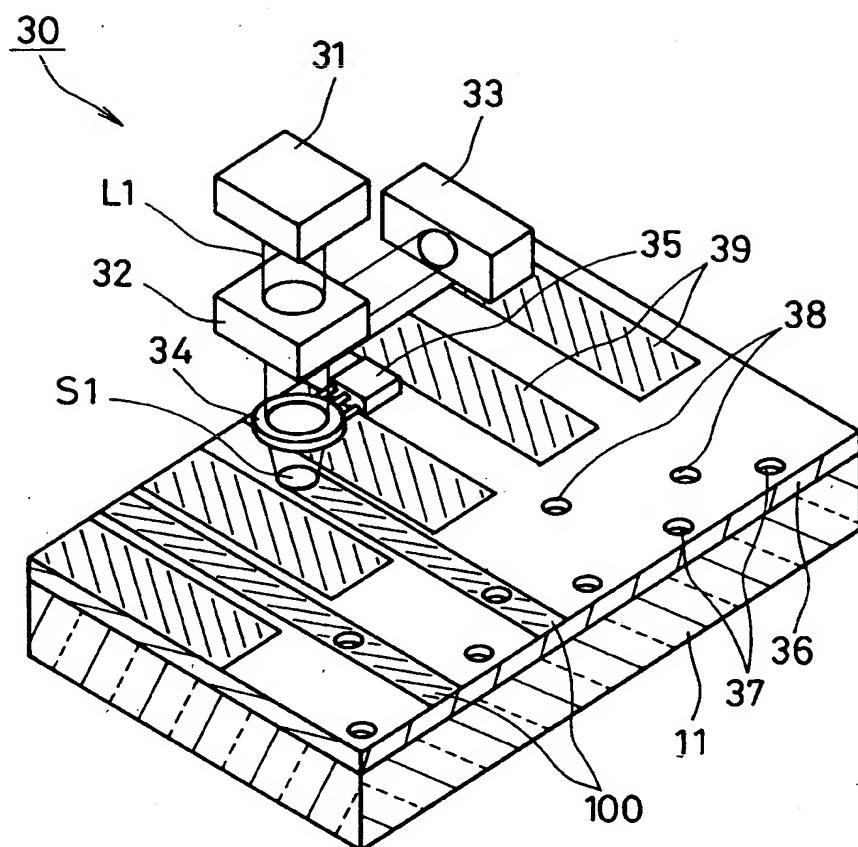
【図1】



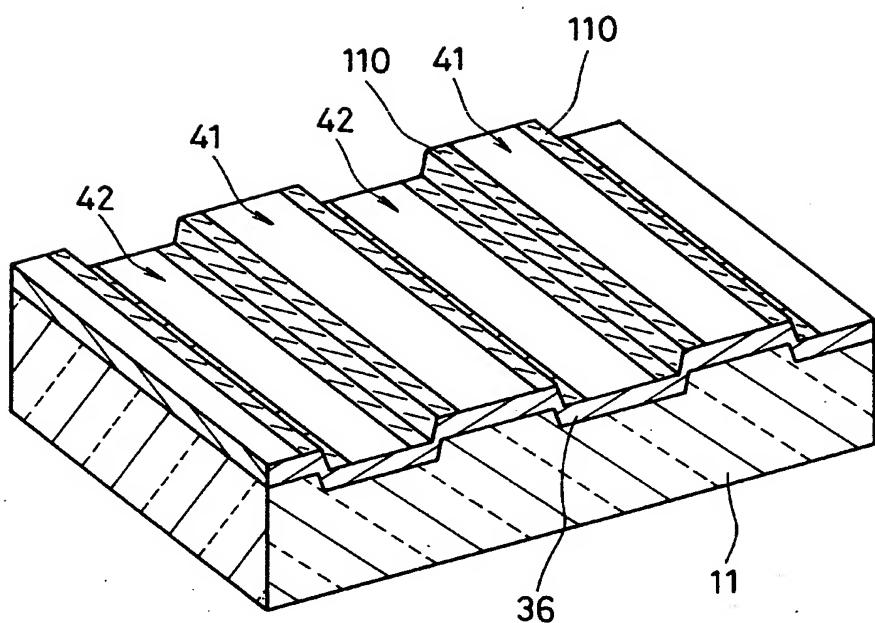
【図2】



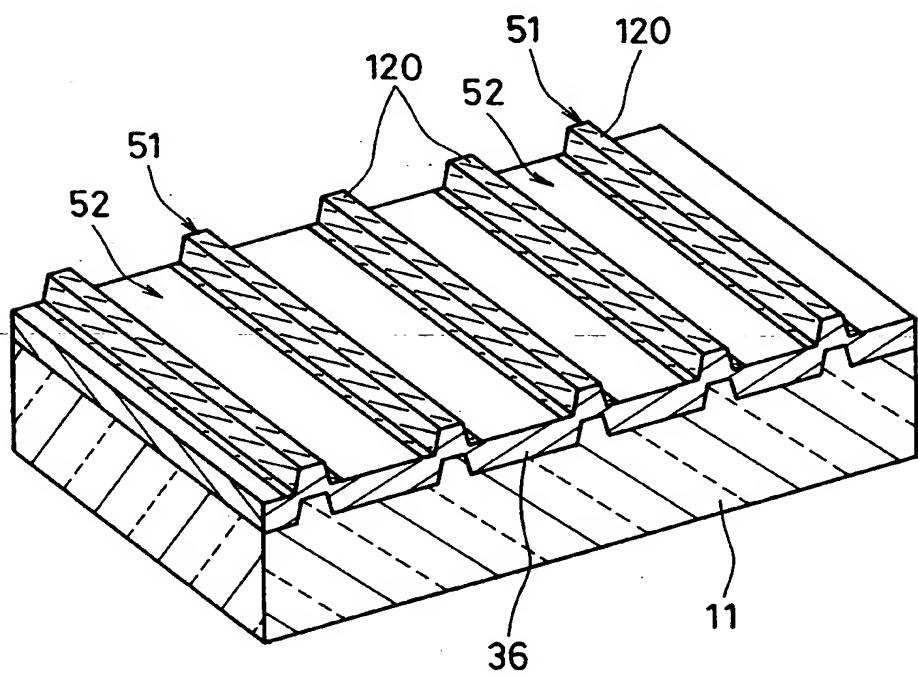
【図3】



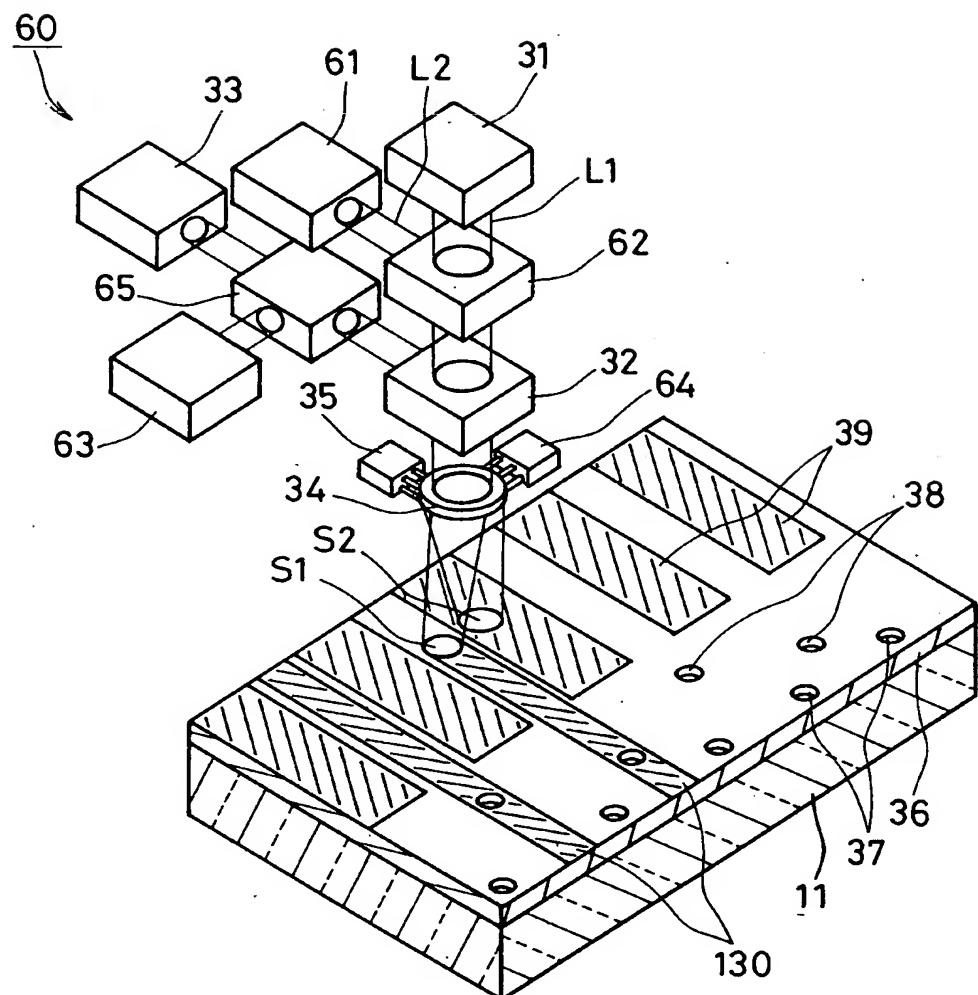
【図4】



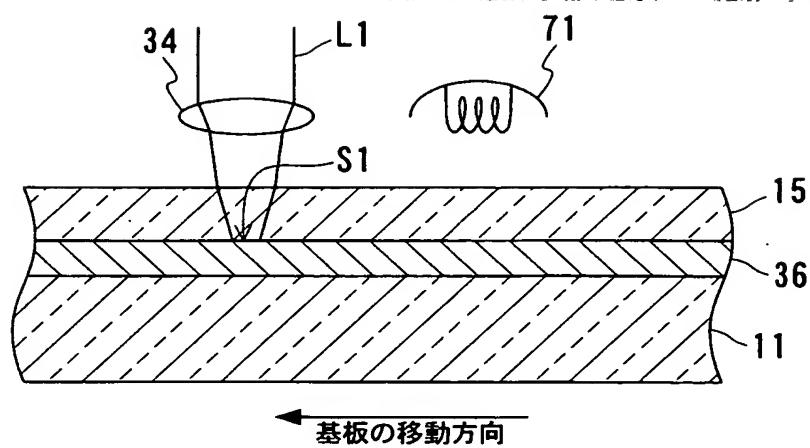
【図5】



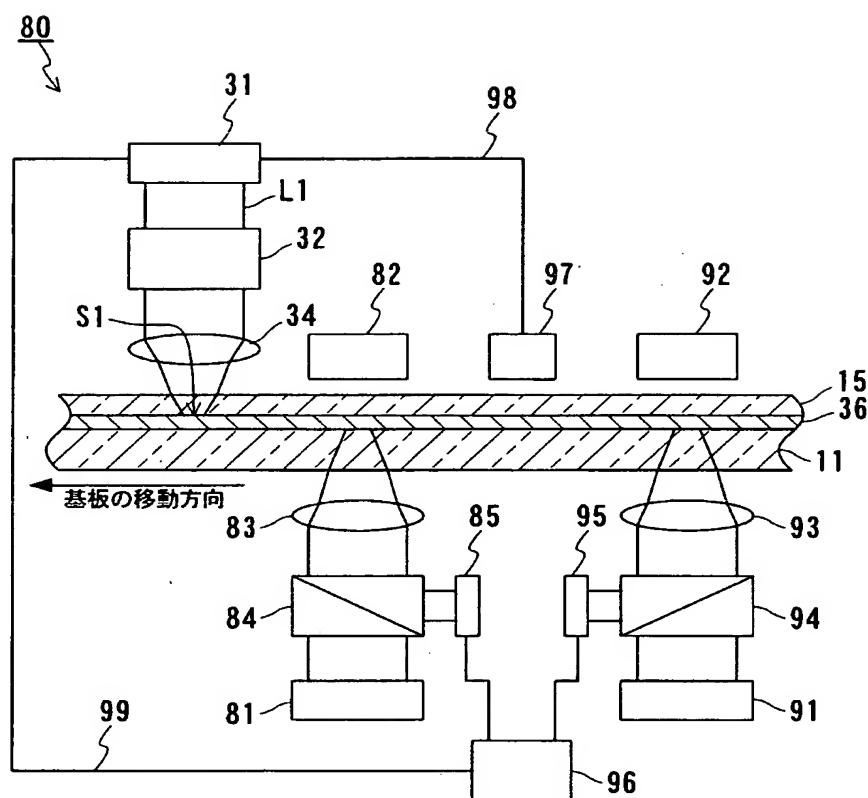
【図6】



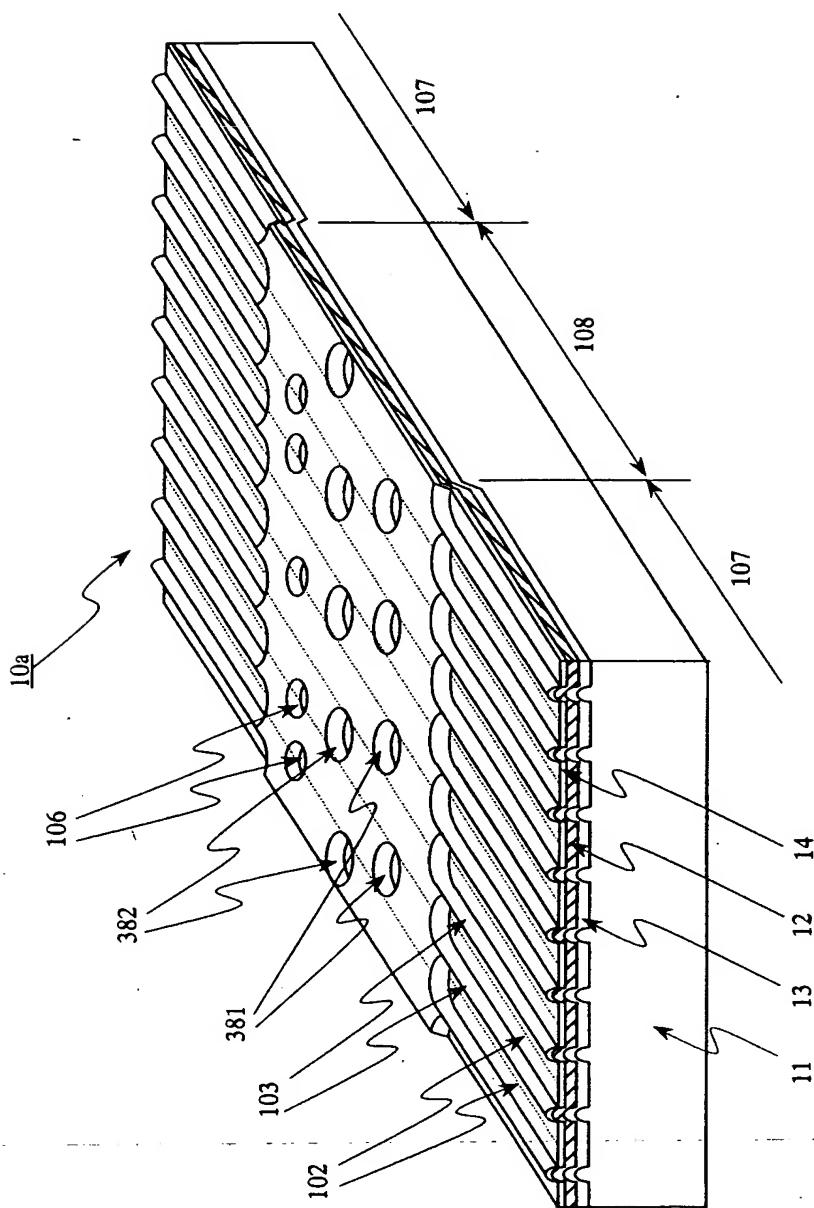
【図7】



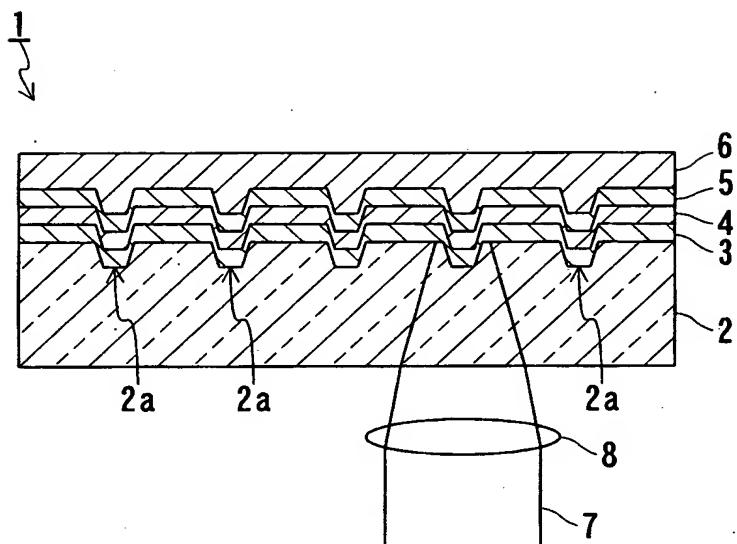
【図8】



【図9】



【図10】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 記録密度が高く、短時間で初期化することができる光ディスクおよびその製造方法を提供する。

【解決手段】 基板11と基板11の上方に配置された記録層12とを備え、基板11側から入射される光を用いてDWDD方式によって情報信号の再生を行う光ディスクであって、基板11と記録層12との間に配置された第1の誘電体層13と、記録層12に対して基板11とは反対側に配置された第2の誘電体層14とを備え、記録層12が第2の誘電体層14側から入射された波長 λ の光を用いて初期化された層であり、第2の誘電体層14の厚さが、 $\lambda / (12 \times n)$ 以上 $\lambda / (2 \times n)$ 以下（ただし、nは第2の誘電体層の屈折率）である。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号 [000005821]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府門真市大字門真1006番地
氏 名 松下電器産業株式会社